



Dr. Olivier THOMAS

Entrepreneur, Expert, Créatif, Ancien sportif confirmé

Résumé

15 ans d'expérience en R&D dans l'industrie du semi-conducteur. Expert en conception de circuits intégrés pour des systèmes numériques embarqués. 7 ans d'expérience dans la gestion de projets R&D à l'international. Initiateur de plusieurs projets collaboratifs entre les instituts de R&D publics et des industriels. Auteur et Co-auteur de 77 publications et 25 brevets. Initiateur, Co-fondateur et Président de la start-up MOOVLAB spécialisée dans la mesure sportive. Ceinture noire 3^{ème} Dan de Viet Vo Dao. Vice-champion de France combat 1999 et Champion de France 2001.

Expérience professionnelle

2017 – Aujourd'hui	MOOVLAB – Grenoble, France – CEO, Co-fondateur En charge de la stratégie de l'entreprise et des partenariats financiers.
2015 – 2017	CEA-Leti – Grenoble, France – Chef de projet Chef de projet Silicon Impulse (8 partenaires industriels internationaux): Déploiement d'un centre de conception dédié aux entreprises innovantes souhaitant développer ou porter des systèmes sur puce (Numérique, Analogique, RF, Mémoire) en technologies avancées. Evaluation des besoins client et mise en relation avec les partenaires. Suivi des projets entrants. Reporting à la direction. Chef de projet EuroCPS (Projet H2020, 15 partenaires industriels et universitaires) : Coordinateur (technique, légal et financier) et responsable du reporting au niveau de la Commission Européenne. Projet à 9M€. Auteur du projet FED4SAE (Projet H2020, 14 partenaires industriels et universitaires) : Rédaction et coordination des contributions des partenaires. Projet de 8M€ accepté par la Commission Européenne en 2017.
2012 – 2014	CEA-Leti – Grenoble, France – Ingénieur de recherche Expert Mise en place et encadrement de l'activité mémoire du laboratoire numérique (LISAN) du CEA-Leti – Responsable d'une équipe de 7 personnes, planification, suivi de projets, reporting au chef de laboratoire et chez le client.
2010 – 2012	CEA-Leti – Université de Berkeley, Californie, Etats-Unis – Ingénieur de recherche sénior Responsable de la collaboration BWRC, STMicroelectronics, CEA-Leti pour la réalisation de démonstrateurs numériques et mémoires en technologie 28 nm FD-SOI. Développement de solutions de caractérisations de circuits mémoire (SRAM) en conditions réelles de fonctionnement dans un système sur puce (SoC).
2005 – 2010	CEA-Leti – Grenoble, France – Ingénieur de recherche Responsable des activités de conception en lien avec les développements de nouveaux process CMOS (MOS double grille, FD-SOI, Nanofils, empilement 3D monolithique...) pour les nœuds technologiques inférieurs à 30nm.

Formation

2017 – 2018	HEC Challenge+ Formation de 8 mois sur l'entrepreneuriat d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.
2001 – 2004	Ecole Doctorale Informatique Télécommunications Electronique (EDITE) – Paris, France Doctorant en conception de circuits intégrés. Sujet de thèse : Conception de circuits mémoire très basse consommation et très basse tension en technologie 65nm PD-SOI. Collaboration avec STMicroelectronics et le CEA-Leti.
1998 – 2001	Institut Supérieur d'Electronique Numérique (ISEN) – Lille, France Formation ingénieur en microélectronique et système de l'information Dominante 3 ^{ème} année: Conception de circuits intégrés numériques (ISEP, Paris)
1996 – 1998	Institut Universitaire Technologique (IUT) – Ville d'Avray, France Diplôme d'université technologique (DUT) en électronique et informatique industriel Dominante : Systèmes numériques

Langues

Français	Langue maternelle
Anglais	Courant (2 ans à Berkeley, Californie, Etats Unis)

Faits marquants

2001 – Aujourd'hui	Auteur et co-auteur de 77 articles dans des conférences et revues internationales et 25 brevets
2012	Récompensé par le meilleur papier de la conférence SOI pour le papier intitulé « 6T SRAM Design for Wide Voltage Range in 28nm FDSOI ».
2011	Transfert technologique de la solution « SPW6T » chez STMicroelectronics et utilisée aujourd'hui chez Samsung et Globalfoundries.
2010	Transfert technologique de la solution « Multi-VT » chez STMicroelectronics et utilisée aujourd'hui chez Samsung et Globalfoundries.
2003	Récompensé pour le brevet « Self-Refresh Partially Depleted SOI SRAM memory cell » par la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) et l'Association des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie (ASPI)
1999 et 2001	Vice-champion de France de combat en Viet Vo Dao, Champion de France de combat en Viet Vo Dao